

H05 k 1

G 03 F 7

C 08 F 283

Ans.nr.: 3633/85

Indleveret: 09 aug 1985

Løbedag: 09 aug 1985

Alm. tilgængelig: 11 feb 1986

Prioritet: 10 aug 1984 DE 3429606

*SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Berlin
und Muenchen, DE.

Opfinder: Klaus *Budde; DE, Friedrich *Koch;
DE, Ferdinand *Quella; DE.

Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau

Termostabilt, ved bestråling tværbindings-
dygtigt polymersystem til mikroelektroniske
anvendelsesformål

S A M M E N D R A G

3633-85

Der angives et termostabilt, ved bestråling tværbin-
dingsdygtigt polymersystem til mikroelektroniske anven-
delsesformål. Til opnåelse af en lav dielektricitetskon-
stant og til forbedring af den vedvarende temperaturbe-
standighed af strålingsfølsomme kunstharpikslakker inde-
holder polymersystemet som udgangsstoffer for omsætnin-
gen lineære fluorpolymere med mindst to reaktive ende-
grupper pr. polymermolekyle. Der indbygges fortrinsvis
perfluorerede polyetherforbindelser og perfluorerede
alkaner. Produktet anvendes som belægning (2, 13, 4)
ved fremstillingen af trykte flerlagskredsløb, og der
spares gennemboringer og yderligere kobbermellemlag. Et
yderligere anvendelsesområde er integrerede halvleder-
koblinger i VLSI-teknik ved frembringelse af negativ-
fotoresister.

FIG 1

3633-85

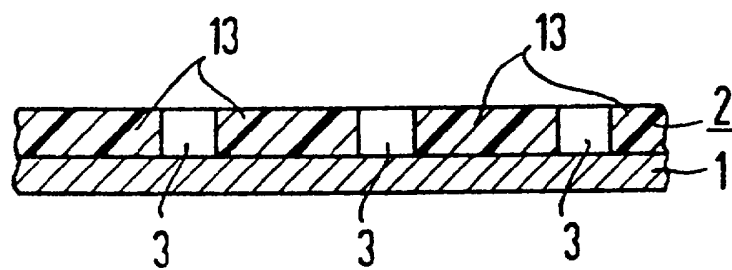


FIG 2

